

УДК 541.183.2

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

С. Ф. ТИМАШЕВ, В. К. ФЕДЯНИН

К МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА
М. И. ТЕМКИНА

(Представлено академиком И. В. Петряновым 22 X 1969)

Для объяснения экспериментально установленного для некоторых систем адсорбент-адсорбат факта линейного падения теплоты адсорбции с покрытием М. И. Темкин выдвинул гипотезу, по которой в системе адсорбированные частицы — металл образуется двумерный электронный газ («двумерный металл»⁽¹⁾). Поскольку в такой системе химический потенциал (уровень Ферми) линейно зависит от поверхностной плотности электронов, определяемой степенью покрытия поверхности, это немедленно приводит к линейному падению теплоты адсорбции с заполнением. В работе⁽¹⁾ все количественные оценки проводятся с использованием зоммерфельдовской модели газа незаимодействующих электронов при абсолютном нуле температуры⁽²⁾. Из этих оценок следует, что падение теплоты адсорбции с покрытием происходит гораздо быстрее, нежели это следует из экспериментальных данных.

Модель М. И. Темкина может быть уточнена в двух направлениях: 1) двумерный электронный газ стабилизируется потенциалом в общем случае хаотически расположенных адсорбированных ионных остовов атомов металла, — это, так сказать, «твердотельный» аспект данной модели; 2) электроны взаимодействуют друг с другом, что является «многочастичным» эффектом⁽³⁾. Известно, что оба эти эффекта можно рассматривать порознь⁽²⁻⁴⁾. Так, в частности⁽¹⁾, влияние дискретности положительного потенциала можно в первом приближении учсть просто заменой в соответствующих формулах массы электрона m его приведенной массой m^* , которая берется из экспериментальных данных по теплоемкости при низких температурах⁽⁴⁾. Ниже мы сосредоточим свое внимание на учете эффекта межэлектронного взаимодействия.

Как известно^(3, 4), одним из существенных достижений теории многих частиц применительно к электронному кулоновскому взаимодействию в металлах явилось выяснение важной роли экранировки кулоновского взаимодействия в них. Сильное дальнодействующее кулоновское взаимодействие в металлах оказывается экранированным таким образом, что поляризация, вызываемая каким-либо зарядом, приводит к почти полной экранировке поля этого заряда на расстояниях порядка среднего межатомного расстояния. Количественно экранировка в гипотетическом «двумерном металле» взаимодействующих электронов изучалась в работах авторов^(5, 6). Фурье-компоненты экранированного потенциала взаимодействия дается следующей формулой⁽⁵⁾.

$$B(p) = 2\pi e^2 A(z) / (p + \chi(p)), \quad \chi(p) = 2a_0^{-1} A(z), \quad z = pl,$$

$$A(z) = \frac{2}{z} - \frac{2(4\pi^2)^2 (1 - e^{-z})}{z^2 (z^2 + 4\pi^2)^2} + \frac{z}{z^2 + 4\pi^2}, \quad (1)$$

Здесь $p = |\mathbf{K}_1 - \mathbf{K}_2|$ — абсолютная величина относительного двумерного волнового вектора двух электронов, a_0 — боровский радиус, l — толщина одноуровневой металлической пленки ($l < 3a_0$).

Полагая, что Фурье-компоненты взаимодействия электронов в модели поверхностного электронного газа дается величиной $B(r)$ из (1), получаем для химического потенциала в e^2 -приближении:

$$\mu = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} + \frac{\pi nl \hbar^2}{m} - e^2 \sqrt{\frac{8nl}{\pi}} \int_0^1 \frac{x \operatorname{arc cos} x A(rx)}{x + b^{-1} A(rx)} dx, \quad (2)$$

здесь n — полная объемная плотность электронов ($nl = \sigma$ — полная поверхностная плотность электронов, пропорциональная покрытию поверхности), $r = \sqrt{8\pi nl^3}$, $b = \sqrt{2\pi nl a_0^2}$ — параметр экранировки, \hbar — постоянная Планка. Интеграл в (2) можно вычислить численно, однако, учитывая, что $A(rx)$ медленно меняющаяся функция (rx), проще разложить $A(z)$ из (1) по (z), взяв следующую аппроксимацию для $A(rx)$:

$$A(rx) \approx 1 - 0,2 rx, \quad (3)$$

приводящую к совпадению с численным расчетом $A(rx)$ по (1) с точностью 5% (законность различных аппроксимаций для $A(z)$ подробно обсуждается в ⁽⁵⁾). Формулы (2) и (3) сразу дают для химического потенциала.

$$\mu = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} + \frac{\pi \sigma \hbar^2}{m} - \frac{e^2 b^2}{4a_0} \left(1 - \frac{16b}{9\pi}\right) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} + \frac{\pi \sigma \hbar^2}{m} \left[1 - \left(0,5 - \frac{8b}{9\pi}\right)\right]. \quad (4)$$

Мы видим, что поправка, обусловленная взаимодействием, существенна: при $\sigma \approx 10^{15}$ для величины b получаем $b \approx 0,42$, и последнее слагаемое в формуле (4) оказывается порядка 21 ккал/г-атом (мы полагаем, что каждый адсорбированный атом отдает по одному электрону), или же порядка 38% от основного члена $\pi \sigma \hbar^2 / m$. Согласно (4) и (1), для теплоты адсорбции имеем:

$$q = V - a\sigma, \quad a = \frac{\pi \delta \hbar^2}{m} \left[1 - \left(0,5 - \frac{8b}{9\pi}\right)\right], \quad (5)$$

V — выигрыш энергии при адсорбции атома на поверхности (см. ⁽¹⁾). Если вводить эффективную массу m , то

$$q = V - a^* \sigma, \quad a^* = \frac{\pi \hbar^2}{m^*} \left[1 - \frac{m^*}{m} \left(0,5 - \frac{8b}{9\pi}\right)\right]. \quad (6)$$

Заметим, что учет взаимодействия электронов в e^2 -приближении корректен до тех пор, пока a (альтернативно a^*) больше нуля.

В заключение подчеркнем, что использование экранированного взаимодействия (1) здесь крайне существенно: именно параметр экранировки $b = \sqrt{2\pi \sigma a_0^2}$ определяет в конечном итоге и величину поправки к μ и характер ее зависимости от σ (соответствующие формулы для μ и однородного «двумерного металла» с неэкранированным потенциалом приведены в ⁽⁵⁾).

Нам хотелось бы поблагодарить М. И. Темкина, обсуждавшего с нами данную работу на всех стадиях ее выполнения и во многом способствовавшего ее появлению.

Физико-химический институт
им. Л. Л. Карпова
Москва

Поступило
20 X 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ М. И. Темкин, Вопросы химической кинетики, катализа и реакционной способности, Изд. АН СССР, 1955. ² Г. Бете, А. Зоммерфельд, Электронная теория металлов, 1938. ³ Д. Пайнс, Элементарные возбуждения в твердых телах, 1965. ⁴ Д. Пайнс, Ф. Нозерь, Теория квантовых жидкостей, 1967. ⁵ С. Ф. Тимашев, В. К. Федянин, Физ. мет. и металловед. (в печати). ⁶ С. Ф. Тимашев, В. К. Федянин, Физ. мет. и металловед. (в печати).